بهبود روش تهیه گرافن اکسید عاملدار شده با Fe₃O4: جذب یونهای +Pb²⁺ و Pd²⁺: جذب یونهای +Pd² و

شبنم ششمانی*، حمیده السادات نجفی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)- شهرری، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی

تاریخ دریافت: ۹۷/۰۵/۱۳ تاریخ تصحیح:۹۸/۰۱/۱۹ تاریخ پذیرش: ۹۸/۰۲/۱۵

چکیدہ

در این تحقیق روش تهیه گرافن اکسید اصلاح شد. با ایجاد تغییراتی در روش استادن مایر، گرافن اکسید با خلوص بیشتر، در مدت زمان کوتاهتر و با فاصله بین لایهای بالا به دست آمد. سپس صفحات گرافن اکسید با ذرات Fe₃O4 عامل دار شد. شناسایی با استفاده از روشهای متداول نظیر طیف سنجی IR و XRD انجام گرفت. سپس جذب یونهای ⁺²DP و ⁺²P از محلول آبی در مجاورت گرافن اکسید عامل دار شده و عامل دار نشده بررسی شد. اثر پارامترهایی نظیر مقدار جاذب، زمان تماس، PH دما و غلظت آلاینده فلزی در میزان جذب مطالعه شد. بیشینه میزان درصد جذب یون سرب با استفاده از گرافن اکسید و گرافن اکسید عامل دار شده با Fe₃O4 به ترتیب ۸/۶۸ و ۹۳٪ به دست آمد. در حالیکه بیشینه میزان درصد جذب یون سرب با استفاده از گرافن اکسید و گرافن اکسید عامل دار شده با Fe₃O4 به ترتیب ۸/۶۸ و ۹۳٪ به دست آمد. در حالیکه بیشینه میزان جذب یون پالادیم با استفاده از این جاذبها به ترتیب ۶۳ و ۸/۸٪ تعیین شد. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که جذب یون سرب و پالادیم از ایزوترمهای فروندلیش و تمکین پیروی می کند. بهترین مدل سینتیک جذب نیز مدلهای سینتیکی الویچ و لاگرگرن است. بر اساس نتایچ به دست آمده می وان گفت که گرافن اکسید عامل دار شده با نانو ذرات 404 مینتیک جذب نیز مدلهای سینتیکی الویچ و لاگرگرن است. بر اساس نتایچ به دست آمده می توان گفت که گرافن اکسید عامل دار شده با نانو ذرات 404 هذاین جذب بالایی داشته و می تواند به عنوان یک جاذب موثر برای یونهای ⁺² می و و PD به کار رود.

۱-مقدمه

در دهه گذشته با گسترش فعالیتهای صنعتی و کشاورزی، ورود آلایندههایی مانند فلزات سنگین در محیط زیست به مقدار زیادی افزایش یافته است. این فلزات حیات اکوسیستمها و سلامتی انسان را به مخاطره میاندازند. جیوه، سرب، آرسنیک، کادمیم و پالادیم نمونهای از فلزات سنگین هستند. این فلزات از طریق صنایع فلزی، ریخته گری، آبکاری، رنگسازی، باتریسازی، دباغی، نساجی، کاغذسازی و پسماندهای صنایع و معادن به محیط زیست وارد می شوند. فلزات سنگین اثرات مخربی بر سلامتی انسان خواهند داشت. از جمله این اثرات می توان به کاهش رشد اندامها، ایجاد سرطان، کندذهنی، اختلال در یادگیری و حافظه، آسیب دیدن سیستم عصبی و اختلالات حرکتی اشاره کرد [۱].

در چند دهه اخیر توجه پژوهشگران به روشهای حذف شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی جلب شده است. از روشهای حذف شیمیایی میتوان رسوبدهی شیمیایی، اکسیداسیون – احیا و تبادل یونی را نام برد. در روش بیولوژیک، از میکروارگانیسمها

^{*} نویسنده مسئوول: دانشیار دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) – شهرری 🦳 shabnam_sheshmani@iausr.ac.ir

برای کنترل و بازیافت فلزات سنگین استفاده میشود. میکروارگانیسمها میتوانند غلظت فلزات را در بافت خود به هزار برابر مقدار موجود در محیط برسانند. در روش فیزیکی که در آن از انواع جاذبها استفاده میشود، به دلیل عملکرد ساده و موثر توجه زیادی را به خود جلب کرده است [۶–7]. امروزه استفاده از نانوجاذبهای مغناطیسی برای حل مسایل زیست محیطی و تصفیه آبهای آلوده به یونهای فلزی و رنگدانهها مورد توجه قرار گرفته است. تصفیه فلزات سنگین به وسیله ذرات مغناطیسی نظیر Fe₃O4 و جمع آوری نانوذرات جاذب از پساب بهوسیله میدان مغناطیسی خارجی به سهولت انجام می شود [۲–۲]. اگرچه با کاهش اندازه ذرات Fe₃O4 میزان جذب افزایش می یابد، اما ظرفیت جذب به دلیل فقدان یا کمبود گروههای عاملی شیمیایی روی سطح جاذب، به نسبت پایین است. بر اساس پژوهشهای انجام شده نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده در مقایسه با جاذبهای مغناطیسی دیگر موثرتر و کاربردیتر میباشند [۱۶-۱۰].

گرافن و گرافن اصلاح شده (مشتقات شیمیایی گرافن)، به دلیل داشتن سطح ویژه بالا، بسترهای بسیار مناسبی برای تثبیت نانو ذرات مغناطیسی هستند. روشهای متعددی برای تهیه مشتقات گرافن مغناطیسی گزارش شده است. یو^۱و همکارانش در سال ۲۰۰۹، با روش تجزیه حرارتی پیش مادهای از آهن، گرافن اکسید مغناطیسی را تهیه کردند. در تحقیق دیگر، یی^۲ و همکارانش از واکنش گرافن اکسید با فریک تری استیل استونات در ۱-متیل-۲-پیریدینول و در دماهای بالا گرافن اکسید مغناطیسی را تهیه نمودند. بررسیها نشان داده است که کامپوزیتهای مغناطیسی بر پایه مشتقات گرافن جاذبهای بسیار خوبی برای جذب فلزات سنگین می باشند. لیو^۳ و همکارانش با استفاده از کامیوزیت گرافن اکسید مغناطیسی سولفونه شده^۴، جذب یون ⁺Cu² از محلول آبی را بررسی کردند. کسیان^۵ و همکارانش گرافن اکسید مغناطیسی عاملدار شده را در جذب فلزاتی نظیر ^{+C}u²⁺، Cu و +Pb²⁺ بررسی کردند. این نانوکامپوزیت حلالیت بسیار خوبی در آب از خود نشان میدهد و با خاصیت مغناطیسی اشباع بالایی که دارد از پتانسیل خوبی به عنوان یک جدا کننده برخوردار است. این کامیوزیت درصد جذب بالایی نشان داده است. به گونهای که پس از ۵ بار استفاده از آن ظرفیت جذبی برابر با ۸۵٪ دارد [۲۷-۱۷]. در پژوهشهای دیگری که توسط محققان کشورمان انجام شده است، کاربرد گرافن اکسید و گرافن اکسید مغناطیسی در جذب فلزاتی نظیر ۲⁴⁺، Cu²⁺ ،Cu²⁺ ،Cu²⁺ ،Cu²⁺ ،Zn²⁺ ،Zn²⁺ ,it -NO₃ و آلاینده های آلی از محلولهای آبی بررسی شد[۳۳-۲۸].

در این تحقیق تهیه گرافن اکسید به روش استادن مایر^۶ اصلاح شد. در اکثر گزارشهای علمی از روش هامرز ^۷ برای تهیه گرافن اکسید استفاده شده است. در حالی که روش به کار گرفته در این پژوهش، سادهتر بوده و محصول این فرایند از خلوص بالاتری

¹ Shu-Hong Yu

- ² Mingxin Ye
- ³ Yun-guo Liu
- ⁴ Sulfonated magnetic graphene oxide composite
- ⁵ Yuezhong Xian
- ⁶ Staudenmaier ⁷ Hummers

برخوردار است. همچنین به دلیل افزایش غلظت اسید، فاصله بین لایهای در گرافیت اکسید افزایش یافته و به حدود ۹ Å میرسد. به این ترتیب از تجمع و تراکم صفحات گرافن اکسید جلوگیری میشود. پس از اطمینان از تهیه گرافن اکسید، این ترکیب با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی Fe₃O4 عاملدار شد. آنگاه عملکرد جذب یونهای ⁺²Pb و ⁺²Pd با استفاده از دو جاذب گرافن اکسید عاملدار شده و عاملدار نشده بررسی شد. پارامترهایی نظیر مقدار جاذب، زمان تماس، *P*H، دما و غلظت آلاینده فلزی مطالعه شد. در پایان سینتیک و ایزوترمهای تعادلی مورد ارزیابی قرارگرفت.

۲-بخش تجربی

۲-۱–مواد شیمیایی و دستگاهها

گرافیت، خلوص ۹۹/۵۵٪، سیگما-آلدریچ، پتاسیم کلرات، KClO3، خلوص ۹۹/۹٪، مرک، سولفوریک اسید، H2SO4، خلوص ۹۷٪، مرک، نیتریک اسید، HNO3، خلوص ۶۳٪، مرک، هیدروکلریک اسید، HCl، خلوص ۳۷٪، مرک، اتیلن گلیکول، (C2H4(OH)2)، خلوص ۹۹/۵٪، مرک، اتانول،C2H6O، خلوص ۹۹/۹٪، مرک، آب دیونیزه ۴ بارتقطیر، H2O، آهن(III) کلرید ۶ آبه، FeCl3.6H2O، خ خلوص ۹۹/۹٪، مرک، آهن(II) کلرید ۶ آبه، FeCl2.6H2O، خلوص ۹۹/۹٪، مرک، سدیم هیدروکسید، NaOH، خلوص ۹۹/۹٪، مرک.

ترازو با دقت ۰/۰۰۰۱ گرم مدل PH ،Sartorius متر مدل Sartorius، دستگاه سانتریفوژ مدل Universal 320 Hettich، حمام التراسونیک مدل Elmasonic 60 H، آون خلا مدل Memmert، آون معمولی مدل Memmert، دستگاه Shaker مدل Heidolph، دستگاه دستگاه گرم کن و همزن مغناطیسی مدل Heidoph، دستگاه طیف سنجی مادون قرمز (IR) مدل Tensor 27 Bruker با استفاده از قرص KBr، دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) مدل Philips PW 1800 Diffractometer، دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Vis، مدل MDKB، مدل MDKB.

۲-۲-بهبود تهیه گرافن اکسید به روش استادن مایر

در این تحقیق، تهیه گرافن اکسید به روش استادن مایر بهبود یافت. برای این منظور، نیتریک اسید (۹ میلی لیتر)، سولفوریک اسید (۲۷ میلی لیتر) در یک حمام یخ صفر درجه همراه با هم زدن شدید با یکدیگر مخلوط شدند. آنگاه پودر گرافیت (۱ گرم) آهسته به این مخلوط اسیدی اضافه شد. سپس پودر پتاسیم کلرات (۵ گرم)، در مدت زمان ۱ ساعت به آهستگی افزوده شد به طوری که دمای آن از 2° ۲۰ فراتر نرود. آنگاه ترکیب مورد نظر مدت ۲ روز در دمای اتاق همراه با هم زدن نگهداری شـد. در نهایت به منظور خالص سازی، ترکیب خمیری سیاه رنگ با آب دیونیزه تا ر سیدن به H برابر با ۷ شستشو داده شد. رسوبات به د ست آمده در آون خلا در دمای $2^{\circ} ۶۰$ خشک شد. در این حالت پودر سیاه رنگ گرافیت اکسید به د ست آمد. برای تهیه گرافن اکسید، مقدار معینی از پودر گرافیت اکسید (۱/۰ گرم) در محلولی از آب و اتانول در برابر امواج الترا سونیک به مدت ۲ ساعت قرار گرفت. بدین ترتیب گرافیت اکسید به گرافن اکسید تبدیل می شود. شناسایی این ترکیب با استفاده از طیف IR در گستره زیر قرمز میانی و پراش پرتو ایکس (XRD) انجام شد.

Fe3O4 - تهیه کامپوزیت گرافن اکسید عامل دار شده با

برای عاملدار کردن گرافن اکسید با Fe₃O₄، گرافن اکسید (۵/۰گرم)، اتیلن گلیکول (۲۰ میلی لیتر) و سدیم استات (۳/۱ گرم) به مدت دو ساعت تحت امواج التراسونیک قرار داده شد تا سوسپانسیون همگن به دست آید. سپس آهن(III) کلرید (۶/۰ گرم)، به مخلوط اضافه و به مدت یک ساعت مخلوط شد. پس از نیم ساعت به اتوکلاو منتقل شد و در آون با دمای ۱۸۰C° به مدت شش ساعت قرار داده شد. پس از اتمام واکنش و خنک شدن، محتویات آن به بشر منتقل شد و سه بار با آب و سه بار با اتانول شستشو داده شد. کامپوزیت تهیه شده در آون خلا به مدت یک ساعت خشک شد [۳۴].

۴-۲-بررسی پارامترهای موثر در جذب یونهای ۲-⁴Pb و ۲d²⁺ از محلول آبی

اثر مقدار جاذب: به محلول حاوی آلاینده فلزی ⁺²Pb و Pb²⁺ و ۲۰ppm) کرافن اکسید و یا گرافن اکسید عامل دار شده با Fe₃O₄ (۲۰۰۰، ۲۰/۰۱، ۲۰/۰۱، ۲۰/۰۱ و ۲۰/۰گرم) اضافه و به مدت چهار ساعت به وسیله همزن مغناطیسی همزده شد. آنگاه جذب محلول ها خوانده شد.

اثر زمان: به محلول حاوی آلاینده فلزی ⁺²Pb و ⁺²Pb (۲۰ppm) کرافن اکسید و یا گرافن اکسید عامل دار شده با Fe₃O₄ و ۲۰۰ دقیقه پس از شروع واکنش از محلول نمونه برداری و (۲۰/۰گرم) اضافه شد. در زمانهای ۳۰، ۶۰، ۲۰، ۱۸۰، ۲۴۰ و ۳۰۰ دقیقه پس از شروع واکنش از محلول نمونه برداری و جذب آنها به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر ثبت شد.

اثر *p*H; برای برر سی اثر *p*H های اسیدی و بازی (در محدوده ۲ تا ۸)، به محلول حاوی آلاینده فلزی ⁺²Pb و ⁺²Pd (۲۰ ppm) اثر *p*H; برای برر سی اثر اسید و سدیم هیدروکسید افزوده شد. سپس جاذب گرافن اکسید و یا گرافن اکسید عاملدار شده با Fe₃O₄ (۰/۰۱) گرم) اضافه و به مدت ۴ ساعت به وسیله همزن مغناطیسی همزده شد. آنگاه جذب محلولها خوانده شد.

اثر دما: به محلول حاوی یونهای فلزی +Pb² و +Pb² (۲۰ppm) بگرافن اکسید و یا گرافن اکسید عامل دار شده با Fe₃O₄ اثر دما: به محلول حاوی یونهای فلزی +Pb² و Pb² (۲۰۰۶ مرم) ا ضافه و به مدت چهار ساعت در دماهای ۱۰، ۲۵، ۲۵، ۴۰، ۴۵ و C[°] ۵۰ قرار داده شد. محلول با آهنربا صاف و جذب آنها ثبت شد.

اثر غلظت آلاینده فلزی: به محلول حاوی آلاینده فلزی⁺²Pb و ⁺²Pd و ۲۵٬۲۰٬۱۵٬۳۰ ۲۵٬۹۳ و ۳۵ ۳۵)، گرافن اکسید و یا گرافن اکسید عاملدار شده با Fe₃O4 (۰/۰۱ گرم) اضافه و به مدت چهارساعت در *p*H برابر با ۴ و دمای C[°] ۲۵ همزده شد. آنگاه نمونهها با آهنربا صاف و جذب آنها خوانده شد.

۲-۵- بررسی تعداد دفعات قابلیت جذب

به منظور بررسی تعداد دفعات قابلیت جذب، جذب یونهای فلزی Pb^{2+} و Pb^{2+} در شرایط بهینه بررسی شد. به ۲۵ میلی لیتر محلول ۲۰ ppm از یونهای فلزی Pb^{2+} و Pb^{2+} در PH برابر با ۴ و دمای ۲۵C °، مقدار ۲۰/۰گرم کامپوزیت گرافن اکسید/Fe₃O₄ افزوده شد و محلول به مدت دو ساعت همزده شد. نمونه با آهنربا صاف و جذب آن به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر ثبت شد. سپس جاذب شستشو داده شد و در آون خلا به مدت یک ساعت در دمای ۶۰C ° قرار داده شد تا خشک شود. آنگاه به طور مجدد در جذب ۲۵ میلی لیتر محلول تا به مدت از یونهای فلزی Pb^{2+} و Pb^{2+} و Pd^{2+} به کار رفت. این مراحل تا پنج بار ادامه داده شد و جذب به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر ثبت شد.

۳-بحث و نتیجه گیری

FT-IR - شناسایی با استفاده از طیف سنجی

طیف FT-IR گرافن اکسید و گرافن اکسید عاملدار شده با Fe₃O4 در گستره ¹-۴۰۰۰ در شکل ۱ نشان داده شده است. در طیف IR این ترکیب دو نوار ارتعاش کششی مربوط به پیوند O–C که به ترتیب متعلق به کربن متصل به گروه هیدروکسیل و کربوکسیل میباشد، به ترتیب در ناحیههای ۱۱۷۱ و ¹-۱۰۹ مشاهده میشود. همچنین نوار ارتعاش کششی مربوط به پیوند HO–C در ناحیه ¹-۱۴۶۷ تابل مشاهده است. از طرف دیگر میتوان دو نوار ارتعاش کششی مربوط به پیوند C=C متعلق به کربنهای اکسید نشده در ناحیه ¹-۱۰۹ و پیوند O=C گروه کربوکسیل در ناحیه ¹-۱۰۷ را ملاحظه C=C متعلق به کربنهای اکسید نشده در ناحیه ¹-۱۴۰۹ و پیوند O=C گروه کربوکسیل در ناحیه ¹-۱۳۰۷ را ملاحظه کرد. در نهایت یک ارتعاش قوی در ناحیه ۲۷۲۸ تا ¹-۲۳۰ متعلق به ارتعاش کششی پیوند H–O نیز دیده میشود. طیف TF-IR ترکیب گرافن اکسید عاملدار شده با ¹-۲۹۶ در شکل ۱(ب) نشان داده شده است. پیک ظاهر شده در حدود ⁻mr C–O که مربوط به ارتعاش پیوند O–F است، بیانگر تشکیل پیوند بین فلز آهن و اکسیژن میباشد. نوار ارتعاش کششی پیوند C–O که مربوط به ارتعاش پیوند O–F است، بیانگر تشکیل پیوند بین فلز آهن و اکسیژن میباشد. نوار ارتعاش کششی پیوند C–C



شکل ۱- طیف IR در گستره زیر قرمز میانی

الف) گرافن اکسید تهیه شده به روش استادن مایر اصلاح شده، ب) کامپوزیت گرافن اکسید عاملدار شده با Fe₃O₄

۲-۳-شناسایی با استفاده از الگوی پراش پرتو ایکس

الگوی XRD گرافن اکسید و گرافن اکسید عاملدار شده با ۲۰۵۹ در شکل ۲ نشان داده شده است. در الگوی XRD گرافن اکسید یک پیک با شدت بسیار بالا در ناحیه 22.3[°] = *0*2 با فضای بین/دیهای Å ۹ و یک پیک بسیار ضعیف در ناحیه [°]8.38 = *0*2 با فضای بین/دیهای Å ۳/۳ که حاکی از وجود مقدار با سیار اندکی از گرافیت اکسید نشده در محیط می با شد، ماهده می شود. تغییر فضای بین/دیهای گرافیت از ۳/۳ به ۹ Å نشان از قرار گرفتن گروههای عاملی اکسیژندار و افزایش ضخامت مفحات کربنی می باشد [۳۵]. لازم به ذکر است که در دیگر روشهای تهیه گرافن اکسید فاصله بین لایهای در گستره ۶ تا Å ۸ متغیر است. در این پژوهش با تغییر نسبت مولی اکسندهها در محیط اسیدی و در زمان کوتاهتر فاصله بین لایهای در گستره ۶ تا Å افزایش یافت [۶۳]. الگوی XRD مربوط به کامپوزیت گرافن اکسید عاملدار شده با ۵٫۹۹ در شکل ۲(ب) نشان داده شده است. در این الگو پیکهایی در ((111) 2014), 53.60 (202) معادی و در زمان کوتاهتر فاصله بین لایهای به Å ۹ افزایش یافت [۶۳]. الگوی XRD مربوط به کامپوزیت گرافن اکسید عاملدار شده با ۵٫۹۵ در شکل ۲(ب) نشان داده شده ۲۹ مست. در این الگو پیکهایی در ((111) 2004), 53.60 (200), 57.04 (200) 20.00 ((111) 2004) افزایش یافت [۶۳]. الگوی XRD مربوط به کامپوزیت می افن اکسید عاملدار شده با ۵٫۹۵ در شکل ۲(ب) نشان داده شده ۲۹ می در این الگو پیکهایی در ((112) 20.04), 53.60 (200), 53.60 (200), 53.60 (200), 54.60 (200), 54.60 (200), 54.60 (200), 55.60 (200), 55.60 (200), 54.60 (200), 55.60 (200), 55.60 (200), 54.60 (200), 54.60 (200), 54.60 (200), 54.60 (200), 54.60 (200), 55.60 (200), 55.60 (200), 55.60 (200), 55.60 (200), 55.60 (200), 55.60 (200), 55.60 (200), 55.60 (200), 55.60 (200), 55.60 (200), 55.60 (200), 55.60 (200),



شكل ٣- الكوى پراش پرتو ايكس (XRD) الف) گرافن اكسيد، ب) گرافن اكسيد عاملدار شده با Fe₃O₄

زاويه تفرق Fe ₃ O ₄		
نمونه تهيه شده	نمونه استاندارد	الديس ميتر (صفحات بنوري)
۱۸/۱۴	18/28	(111)
۳۰/۲۰	٣•/١٠	(77.)
30/22	30/40	(۳۱۱)
47/11	44/12	(۴۰۰)
۵۳/۶۰	54/41	(477)
۵۷/۰۴	$\Delta V / \cdot 1$	(۵۱۱)
87/07	۶۲/۵۸	(44.)
۲۴/۰۶	۲۴/ <i>۰۶</i>	(۵۳۳)

جدول ۱-مقایسه زاویههای تفرق ترکیب Fe₃O4 استاندارد و نانوذرات مغناطیسی تثبیت شده روی گرافن اکسید

Fe3O4 - مغناطوسنجی کامپوزیت گرافن اکسید عامل دار شده با

نمودار مغناطوسنجی کامپوزیت گرافن اکسید عامل دار شده با Fe₃O₄ در شکل ۴ نشان داده شده است. با توجه به منحنی مغناطوسنجی، حلقه هیسترزیس (حلقه پسماند) وجود دارد. این ماده به میدان مغناطیسی بزرگی برای مغناطیس شدن نیاز ندارند و در دسته مواد فرومغناطیس قرار میگیرند. این ترکیب دارای مغناطیس اشباع ۴۱/۸۳ emu/g میباشد.



شکل ۴- نمودار مغناطوسنجی گرافن اکسید عاملدار شده با Fe₃O₄

۴-۳-تصاوير ميكروسكوپ الكتروني (SEM)

تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) نمونه های گرافن اکسید و گرافن اکسید عامل دار شده با Fe₃O4 در شکل ۵ نشان داده شده است. در این تصاویر نانو ذرات مغناطیسی با مورفولوژی کروی و با اندازه تقریبی ۲۹ نانومتر روی صفحههای گرافن قرار گرفته است.



الف)





شکل ۵- تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) الف) گرافن اکسید، ب) گرافن اکسید عامل دار شده با ۶۰۹، ج) نانوذرات کروی Fe₃O₄

۵-۳-شناسایی با استفاده از طیف سنجی پراش انرژی پر تو ایکس (EDXA)

تعداد و انرژی پرتو-X ساطع شده از یک نمونه را میتوان به کمک طیفسنج پراش انرژی پرتو-X اندازه گیری کرد. از آنجا که انرژی این پرتوها بیانگر اختلاف انرژی بین دو لایه و همچنین ساختار اتمی عنصری است که از آن ساطع شدهاند، امکان اندازه گیری ترکیب عناصر نمونه وجود دارد. در شکل ۶ آنالیز EDXA کامپوزیت گرافن اکسید/Fe₃O4 نشان داده شده است. آهن با ۱۶/۶۵ درصد وزنی، کربن با ۶۴/۲۰ درصد وزنی و اکسیژن با ۱۷/۵۱ درصد وزنی میباشد.

ج)

ب)



شکل ۶- طیف سنجی پراش انرژی پرتو-X (EDXA) کامپوزیت گرافن اکسید عامل دار شده با Fe₃O₄

۶-۳-بررسی سینتیکی جذب به وسیله گرافن اکسید و یا گرافن اکسید عامل دار شده با Fe₃O₄ اکن اکسید و یا گرافن اثر تغییر غلظت جاذب: در این بخش تغییرات درصد جذب سرب و پالادیم برحسب مقدار گرم جاذب گرافن اکسید و یا گرافن اکسید عامل دار شده با Ge₃O₄ بررسی شد (نمودارهای ۱ (الف) و ۲ (الف)). سیر نزولی این نمودارها نشان می دهد که با افزایش غلظت جاذب و تجمع آن در محیط، برهم کنش آلایندههای فلزی با سطح جاذب و در نتیجه میزان جذب کاهش می یابد. لازم به ذکر است که کامپوزیت گرافن اکسید عامل دار شده با Ge₃O₄ برمی شد (نمودارهای ۱ (الف) و ۲ (الف)). سیر نزولی این نمودارها نشان می دهد که با افزایش غلظت جاذب و تجمع آن در محیط، برهم کنش آلایندههای فلزی با سطح جاذب و در نتیجه میزان جذب کاهش می یابد. لازم به ذکر است که کامپوزیت گرافن اکسید عامل دار شده با Ge₃O₄ بهتر از گرافن اکسید عمل کرده است. این نکته وجود برهم کنشهای الکتروستاتیکی میان 40.5 و یونهای ⁺²O₇O₄ و ²O₁ ثابت می کند. میزان درصد جذب سرب به ازای 1.۰۰ گرم از گرافن اکسید و گرافن اکسید مغناطیسی به ترتیب ۸۰ و ۵/۹۱ درصد است. همچنین میزان درصد جذب برای پالادیم با استفاده از گرافن اکسید و گرافن اکسید مغناطیسی به ترتیب ۵۰ و ۵/۹۱ درصد است. همچنین میزان درصد جذب برای پالادیم با استفاده از گرافن اکسید و گرافن اکسید مغناطیسی به ترتیب ۵۰ و ۵/۹۱ درصد است. همچنین میزان درصد جذب برای پالادیم با استفاده درافن اکسید و گرافن اکسید و گرافن اکسید مغناطیسی به ترتیب ۵۰ و ۵/۹ در ۲۰ درصد به دست آمد.

اثر تغییر زمان: پس از تهیه محلولها با مقدارگرم بهینه جاذب (۲۰/۱گرم)، جذب آلاینده در زمانهای ۳۰، ۶۰، ۲۰، ۲۰، ۲۴ و۳۰۰ دقیقه بررسی شد و نمودار جذب یونهای سرب و پالادیم بر حسب زمان رسم شد (نمودارهای ۱ (ب) و ۲ (ب)). همان طور که در این نمودارها مشاهده می شود با افزایش زمان تا ۲۴۰ دقیقه میزان جذب افزایش یافته و پس از آن ثابت می ماند. بیشینه مقدار جذب سرب در ۲۴۰ دقیقه با جاذب گرافن اکسید و کامپوزیت گرافن اکسید عامل دار شده با Fe₃O₄ به ترتیب برابر با ۷۷ و ۸۹٪ می باشد. بیشینه مقدار جذب پالادیم با استفاده از این جاذبها به ترتیب ۵۹/۵ و ۸۷ درصد به دست آمد.

اثر تغییر pH با به دست آوردن مقادیر درصد جذب، نمودار درصد جذب بر حسب pH در گستره ۲ تا ۸ رسم شد (نمودارهای ۱ (ج) و ۲ (ج)). همان طور که ملاحظه می شود با افزایش مقدار pH میزان جذب آلاینده ها کاهش می یابد. به طوری که در pH های ۲ تا ۴ گستره درصد جذب یون سرب با استفاده از گرافن اکسید و کامپوزیت گرافن اکسید عامل دار شده با Fe₃O₄ به ترتیب (۸۷/۵ تا ۸۶/۵/) و (۹۴ تا ۹۳٪) است. همچنین گستره درصد جذب یون پالادیم (۶۳/۵ تا ۶۳) و (۷۲ تا ۷۱) به دست آمد. به دلیل وجود مشکلات زیست محیطی و صنعتی PH های اسیدی، همه بهینه سازی ها در ۴= *p*H انجام شد.

اثر تغییر دما: پس از افزایش میزان بهینه جاذب (۰/۰۱ گرم) به محلولهای سرب و پالادیم در *P*H و زمان بهینه، دما در گستره ۱۰ تا C[°] ۵۰ تغییر داده شد. بدین ترتیب نمودار مقادیر درصد جذب بر حسب دما برای جاذب گرافن اکسید و یا کامپوزیت گرافن اکسید عاملدار شده با Fe₃O₄ رسم شد (نمودارهای ۱ (د) و ۲ (د)). با افزایش دما دسترسی و امکان برخورد یونهای فلزی و جاذب بیشتر می شود. بیشینه میزان جذب سرب در دمای C[°] ۲۵ با استفاده از گرافن اکسید و گرافن اکسید مغناطیسی به ترتیب ۸۶/۸٪ و ۹۳٪ می باشد. همچنین بیشینه میزان جذب پالادیم در این دما ۳۶ و ۱۰٪٪ است.

اثر غلظت آلاینده فلزی: برای بررسی اثر غلظت آلاینده فلزی بر میزان جذب، محلولهای سرب و پالادیم با غلظتهای ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰ و ppm ۳۵ آماده شد. مشابه آنچه که در قسمتهای قبل گفته شد، افزایش آلاینده فلزی در شرایط بهینه (دما، زمان، *H* و میزان جاذب) انجام شد. آنگاه نمودار تغییرات جذب بر حسب غلظت آلاینده رسم شد (نمودارهای ۱ (ه) و ۲ (ه)). همانطور که ملاحظه می شود، میزان جذب با افزایش غلظت آلاینده افزایش مییابد و در مقادیر بالاتر از ppm ۲۵ ثابت می ماند. میزان درصد جذب سرب با استفاده از جاذب گرافن اکسید و کامپوزیت گرافن اکسید عاملدار شده با Fe₃O₄ به ترتیب ۶۶/۸ و ۹۳/۰ به دست آمد. مقدار درصد جذب پالادیم با استفاده از این جاذبها به ترتیب ۳/۳ و ۷۱/۰٪ تعیین شد.

۴-۳-بازیافت جاذب

نمودار ۳ نتایج حاصل از میزان جذب یونهای سرب و پالادیم را بر حسب تعداد دفعات بازیافت جاذب نشان میدهد. همانطور که ملاحظه میشود استفاده مجدد از جاذب منجر به کاهش فرایند جذب میشود. در جذب ⁺²Pb، میزان جذب پس از چهار بار استفاده از جاذب به ۷۶٪ رسید. این مقدار در جذب ⁺²Pd پس از چهار بار بازیافت جاذب به ۶۵٪ رسیده است. دلیل این امر تخریب جاذب به دلیل مدت زمان زیاد تماس میباشد که در هر بار عمل جذب نزدیک به دو ساعت و در کل ۸ ساعت در واکنش جذب شرکت میکند.

۵-۳-بازیافت جذب شونده

به منظور بازیافت جذب شونده، شستشوی جاذب با حجمهای مختلف از محلول هیدروکلریک اسید یک مولار انجام شد. بررسیها نشان داد که مقدار ۲۵ میلی لیتر هیدروکلریک اسید یک مولار برای بازیابی ۸۳٪ سرب و ۶۵٪ پالادیم کافی است. تغییرات درصد بازیافت فلز سرب برحسب مقدار هیدروکلریک اسید یک مولار در نمودار ۴ نشان داده شده است. ۶–۳–سینتیک جذب یونهای ⁺¹Pb²⁺ و ⁺¹Pd²⁺ با استفاده از گرافن اکسید و گرافن اکسید عاملدار شده با Fe₃O₄ با استفاده از نتایج آزمایش جذب سرب و پالادیم، نمودارهای سینتیکی لاگرگرن^۸، الوویچ^۹ و بلنچارد^{۱۰} رسم شد (نمودارهای ۵ و ۶). جذب یونهای ⁺²d و ⁺²Pd به وسیله گرافن اکسید و کامپوزیت گرافن اکسید عامل دار شده با Fe₃O₄ به ترتیب از معادله و ۶). جذب یونهای ⁺²d و ⁺²d به و²⁺ و Pd²⁺ به ترتیب از معادله و ۶). جذب یونهای ⁺²d و ⁺²d به و²⁺ و بلنچارد^{۱۰} رسم شد (نمودارهای ۵ و ۶). جذب یونهای ⁺²d و ⁺²d به و²⁺ و Pd²⁺ به ترتیب از معادله از ۶). جذب یونهای ⁺²d و ⁺²d و ⁺²d به ترتیب از معادله است که سینتیک لاگرگرن و الوویچ در جذب یونهای فلزی بهتر عمل کرده است. دادههای تجربی روی یک خط منطبق شـدهاند و ضـریب همبسـتگی²(R) بیشـتری را از خود نشـان می دهند. در این نمودارها، ¹d مقدار ماده جذب شـونده، ²d ماطبق شـدهاند و ضـریب همبسـتگی²(R) بیشـتری را از خود نشـان می دهند. در این نمودارها، ¹d مقدار ماده جذب شـونده، ²d ماطبق شـدهاند و ضـریب همبسـتگی²(R) بیشـتری را از خود نشـان می دهند. در این نمودارها، ¹d مقدار ماده جذب شـونده، ²d ماطبق ماده جذم جذب در زمان ۲ اسـت. ¹d ماده ¹d ماده جذب شـونده، ²d ماده جذم جذم ماده به ازای واحد جرم جاذب در زمان ۲ اسـت. ²d ماده ¹d ماده ¹d ماده مدن ¹d ماده ¹d

معادله ۱

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e)V}{W}$$

تبعیت از لاگرگرن بدین مفهوم است که واکنش به صورت یک واکنش شبه مرتبه اول پیش میرود. الوویچ رابطهای است که در آن جذب سطحی مایعات روی جامدات ناهمگن کاربرد دارد.

ب)

د)





الف)





⁸ Logergren ⁹ Elovich

¹⁰ Blanchard

¹⁰ Blanchard







نمودار ۲ – اثر تغییرات الف) غلظت جاذب، ب) زمان، ج) PH، د) دما و ه) غلظت آلاینده فلزی در میزان جذب پالادیم با استفاده از گرافن اکسید (🔷) و گرافن اکسید عامل دار شده با Fe₃O4 (اله)



نمودار ٣- تغييرات ميزان جذب الف) يون سرب، ب) يون پالاديم بر حسب تعداد دفعات بازيافت جاذب



هیدروکلریک اسید ۱ مولار (میلی لیتر)

نمودار ۴- تغییرات درصد بازیافت فلز سرب برحسب مقدار هیدروکلریک اسید یک مولار

۷-۳-مطالعه و بررسی ایزوترمهای تعادلی

آزمایشهای ترمودینامیکی جذب آلایندههای فلزی سرب و پالادیم انجام شد و منحنی ایزوترم لانگمویر^{۱۱}، فروندلیش^{۱۲} و تمکین^{۱۲} رسم شد (نمودارهای ۷ و ۸). مقدار ضریب همبستگی ایزوترم فروندلیش و تمکین در جاذب گرافن اکسید و گرافن اکسید مغناطیسی از بقیه مقدارها بیشتر بوده و در جذب یونهای ⁺²Pd و ⁺²Pd بهتر عمل کرده است. زمانی که سطح جاذب یکنواخت باشد، رابطه لانگمویر به خوبی جوابگو است. اما در صورت ناهمگن بودن سطح، رابطه لانگمویر نمی تواند رابطه مناسبی باشد و ایزوترم جذب از رابطه فروندلیش و تمکین تبعیت می کند. فروندلیش ثابت کرد که جاذب را می توان به اجزای کوچکتری تقسیم کرد به گونهای که هر بخش گرمای ویژه جذب خود را دارد. همچنین در رابطه تمکین می توان گفت که جذب تک مولکولی بوده و دافعهای بین جذب شوندهها نیز وجود ندارد. این نتایج با دادههای آزمایشگاهی این پژوهش نیز مطابقت دارد.

¹¹ Langmuir

¹² Freundlich

¹³ Temkin



نمودار ۵ – سینتیک جذب یون +Pb²⁺ با استفاده از جاذب گرافن اکسید(🔷) و کامپوزیت گرافن اکسید عامل دار شده با Fe₃O₄ (الف) لاگرگرن، ب) الوویچ، ج) بلنچارد



نمودار ۶ – سینتیک جذب یون +Pd²⁺ با استفاده از جاذب گرافن اکسید(🔷) و کامپوزیت گرافن اکسید عامل دار شده با Fe₃O4 (📥) الف) لاگرگرن، ب) الوویچ، ج) بلنچارد



نمودار ۲- نمودار ایزوترم جذب یون +Pb² با استفاده از گرافن اکسید (🄷) و کامپوزیت گرافن اکسید عامل دار شده با Fe₃O₄ (📥) الف) فروندلیش، ب) تمکین، ج) لانگمویر



نمودار ۸- نمودار ایزوترم جذب یون +Pd² با استفاده از گرافن اکسید (🔷) و کامپوزیت گرافن اکسید عامل دار شده با Fe₃O₄ (📥) الف) فروندلیش، ب) تمکین، ج) لانگمویر

۴-نتیجه گیری

در این تحقیق روش تهیه گرافن اکسید اصلاح شد. سپس گرافن اکسید با ذرات Fe₃O₄ عامل دار شد. با استفاده از طیف سنجی FT-IR گروههای عاملی گرافن اکسید و پیوند آهن- اکسیژن در کامپوزیت گرافن اکسید عامل دار شده با Fe₃O₄ اثبات شد. الگوی پراش پرتو ایکس گرافن اکسید و کامپوزیت تهیه شده با الگوی پراش پرتو ایکس استاندارد یکسان است. پارامترهای موثر در جذب یونهای ⁺²Pd و ⁺²Pd با استفاده از گرافن اکسید و گرافن اکسید عامل دار شده با Fe₃O₄ و غلظت آلاینده در گستره ۲ تا ۸، زمان جذب در گستره ۳۰ تا ۳۰۰ دقیقه، مقدار جاذب در گستره ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم و غلظت آلاینده در مقدارهای ۱۰ تا Mq مان جذب در گستره ۳۰ تا ۳۰۰ دقیقه، مقدار جاذب در گستره ۲۰۰۱ ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ گرم و غلظت آلاینده در مقدارهای ۱۰ تا mq ۳۵ تغییر داده شد. مقدار جذب سرب در شرایط بهینه با استفاده از گرافن اکسید و یا کامپوزیت گرافن اکسید عامل دار شده با ۶۹۵۹ به ترتیب ۸/۸۵ و ۹۳٪ بهدست آمد. میزان جذب پالادیم با استفاده از این جاذبها به ترتیب ۳۶ و ۸۸٪ تعیین شد. میزان جذب ⁺²Dd و ⁺²Dd پس از چهار بار استفاده از جاذب به ترتیب به ۶۷ و ۵۶٪ رسید. همچنین شستشوی جاذب در ۲۵ میلی لیتر هیدروکلریک اسید یک مولار منجر به بازیابی ۳۸٪ سرب و ۵۵٪ رسید. همچنین آزمایشگاهی با استفاده از جاذبهای گرافن اکسید و کامپوزیت گرافن اکسید عامل دار شده با ۸۹۵۹ فروندلیش و تمکین تطابق بهتری دارند. بهترین مدل سینتیکی جذب نیز مدل سینتیکی لاگرگرن و الوویچ است.

[1] M. Jaishankar, T. Tseten, N. Anbalagan, B. B. Mathew and K. N. Beeregowda, *Interdiscip Toxicol.* 7 (2014) 60.

[2] S. Sharma, S. Rana, A. Thakkar, A. Baldi, R. S. R. Murthy and R. K. Sharma, *Journal of Heavy Metal Toxicity and Diseases* **1** (2016) 1.

- [3] M. Abdel Salam, Int. J. Environ. Sci. Technol. 10 (2013) 677.
- [4] R. Gong, Y. Ding, H. Liu, Q. Chen and Z. Liu, Chemosphere 58 (2005) 125.
- [5] V. K. Gupta and A. Rastogi, J. Hazard. Mat. 152 (2008) 407.
- [6] H. Mohammed, B. Gutti and B. K. Highina, International Journal of Environment 5 (2016) 104.
- [7] I. Gehrke, A. Geiser and A. Somborn-Schulz, Nanotechnol. Sci. Appl. 8 (2015) 1.
- [8] S. Singh, K. C. Barick and D. Bahadur, J. Hazard. Mat. 192 (2011) 1539.

[9] Y. Xu, C. Li, X. Zhu, W. E. Huang and D. Zhang, *Environmental Engineering and Management Journal* 8 (2014) 2023.

- [10] H-P. Cong, J-J. He, Y. Lu and S-H. Yu, Small 6 (2010) 169.
- [11] G. Li, Z. Zhao, J. Liu and G. Jiang, J. Hazard. Mat. 192 (2011) 277.
- [12] J-F. Liu, Z-S. Zhao and G-B. Jiang, Environ. Sci. Technol. 42 (2008) 6949.
- [13] J. Wang, S. Zheng, Y. Shao, J. Liu, Z. Xu and D. Zhu, J. Colloid and Interface Science 349 (2010)293.

[14] X. Xin, Q. Wei, J. Yang, L. Yan, R. Feng, G. Chen, B. Du and H. Li, *Chemical Engineering Journal* **184** (2012) 132.

[15] W. Yantasee, C. L. Warner, T. Sangvanich, R. S. Addleman, T. G. Carter, R. J. Wiacek, G. E. Fryxell, C. Timchalk and M. G. Warner, *Environ. Sci. Technol.* **41** (2007) 5114.

[16] W. Zhang, X. Shi, Y. Zhang, W. Gu, B. Li and Y. Xian, J. Material Chemistry A 1 (2013) 1745.

[17] S. Zhang, Y. Zhang, J. Liu, Q. Xu, H. Xiao, X. Wang, H. Xu and J. Zhou, *Chemical Engineering Journal* **226** (2013) 30.

[18] L. Cui, Y. Wang, L. Gao, L. Hu, L. Yan, Q. Wei and B. Du, *Chemical Engineering Journal* **281** (2015) 1.

[19] L. Fan, C. Luo, M. Sun, X. Li and H. Qiu, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 103 (2013) 523.

[20] X. Guo, B. Du, Q. Wei, J. Yang, L. Hu, L. Yan and W. Xu, J. Hazard. Mat. 278 (2014) 211.

[21] X-J. Hu, Y-G. Liu, H. Wang, A-W. Chen, G-M. Zeng, S-M. Liu and Y. M. Guo, *Separation and Purification Technology* **108** (2013) 189.

[22] J. Shen, Y. Hu, M. Shi, N. Li, H. Hongwei Ma and M. Ye, J. Physic. Chem. C 114 (2010) 1498.

[23] J. H. Yang, B. Ramaraj and K. R. Yoon, J. Alloys and Compounds 583 (2014) 128.

[24] X. Yang, X. Zhang, Y. Ma, Y. Huang, Y. Wang and Y. Chen, J. Mater. Chem. 19 (2009) 2710.

[25] A. I. A, Sherlala , A. A. A. Raman , M. M. Bello and A. Asghar, Chemosphere 193 (2018) 1004.

[26] L. P. Lingamdinne, I. S. Kim, J. H. Ha, Y.-Y. Chang, J. R. Koduru and J. K. Yang, *Metals* 7 (2017) 225.

[27] Y. X. Ma, W. J. Shao, P. S. Jin, Y. L. Kou and X. Li, *Polymer Composites* (2018) doi.org/10.1002/pc.25122.

[28] N. Zolfaghari, R. M. A. Tehrani and F. Hooshyar, *Journal of water and Wastewater* 29 (2018) 81.
[29] G. Ghanizadeh, A. Azari, H. Akbari and R. R Kalantary, *Journal of Mazandaran University of Medical Sciences* 25 (2015) 49.

[30] A. Azari, M. Salari, M. H. Dehghani, M. Alimohammadi, H. Ghaffari, K. Sharafi, N. Shariatifar and M. Baziar, *Journal of Mazandaran University of Medical Sciences* **26** (2017) 265.

[31] N. Danesh, A. Marjani, M. Ghorbani and M. Hosseini, *Journal of Environmental Health Engineering* **5** (2017) 1.

[32] A. Naghizadeh and F. Momeni, Journal of Birjand University of Medical Sciences 22 (2015) 27.

[33] A. Khaligh, H. Z. Mousavi and A. Rashidi, J. of Applied Chemistry 11 (2016) 49, in Persian.

[34] Y. Zhan, F. Meng, X. Yang, R. Zhao and X. Liu, *Materials Science and Engineering* **B 176** (2011) 1333.

[35] C. Hontoria-Lucas, A. López-Peinado, J. López-González and R. Martin-Aranda, *Carbon* 33 (1995) 1585.

[36] S. Sheshmani and M. Arab Fashapoyeh, Acta Chim. Slov. 60 (2013) 813.

[37] G. Wang, X. Shen, B. Wang, J. Yao and J. Park, *Carbon* 47 (2009) I 359.
[38] M. Wojtoniszak and E. Mijowska, *J. Nanopart. Res.* 14 (2012) 1248.